

NPN POWER SILICON TRANSISTOR

Devices

2N4150
2N4150S

2N5237
2N5237S

2N5238
2N5238S

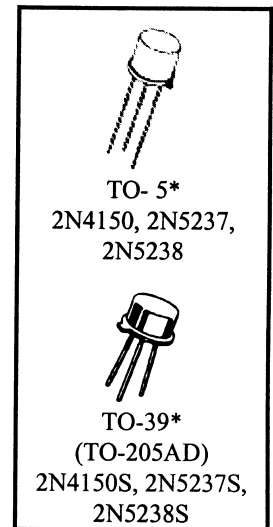
MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N4150	2N5237	2N5238	Unit
		2N4150S	2N5237S	2N5238S	
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	70	120	170	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	100	150	200	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	10			Vdc
Collector Current	I_C	10			Adc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}^{(1)}$ @ $T_C = +100^{\circ}\text{C}^{(2)}$	P_T	1.0			W
		5.0			
Operating & Storage Junction Temp. Range	T_J, T_{stg}	-65 to +200			$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	0.020	$^{\circ}\text{C}/\text{mW}$
Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	0.175	

- Derate linearly @ 5.7 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_A > +25^{\circ}\text{C}$
- Derate linearly @ 50 mW/ $^{\circ}\text{C}$ for $T_C > +25^{\circ}\text{C}$



*See appendix A for package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_C = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Emitter-Base Breakdown Voltage $I_E = 10 \mu\text{Adc}$	$V_{(BR)EBO}$	7.0		Vdc
Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 0.1 \text{Adc}$	$V_{(BR)CEO}$	70 120 170		Vdc
Collector-Emitter Cutoff Current $V_{EB} = 0.5 \text{Vdc}, V_{CE} = 60 \text{Vdc}$ $V_{EB} = 0.5 \text{Vdc}, V_{CE} = 110 \text{Vdc}$ $V_{EB} = 0.5 \text{Vdc}, V_{CE} = 160 \text{Vdc}$	I_{CEX}		10 10 10	μAdc

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
OFF CHARACTERISTICS (con't)				
Collector-Base Cutoff Current $V_{CE} = 60 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 110 \text{ Vdc}$ $V_{CE} = 160 \text{ Vdc}$	I_{CEO}		10 10 10	μAdc
		2N4150, 2N4150S		
		2N5237, 2N5237S 2N5238, 2N5238S		
Emitter-Base Cutoff Current $V_{BE} = 7.0 \text{ Vdc}$ $V_{BE} = 5.0 \text{ Vdc}$	I_{EBO}		10 0.1	μAdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 100 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 150 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 200 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 80 \text{ Vdc}$	I_{CBO}		10 10 10 0.1	μAdc
		2N4150, 2N4150S		
		2N5237, 2N5237S 2N5238, 2N5238S		
		All Types		

ON CHARACTERISTICS (3)

Forward-Current Transfer Ratio $I_C = 1.0 \text{ Adc}, V_{CE} = 5.0 \text{ Vdc}$	h_{FE}	2N4150, 2N4150S	50	200	
		2N5237, 2N5237S	50	225	
		2N5238, 2N5238S	50	225	
$I_C = 5.0 \text{ Adc}, V_{CE} = 5.0 \text{ Vdc}$		All Types	40	120	
$I_C = 10 \text{ Adc}, V_{CE} = 5.0 \text{ Vdc}$	All Types		10	-	
Collector-Emitter Saturation Voltage $I_C = 5.0 \text{ Adc}, I_B = 0.5 \text{ Adc}$ $I_C = 10 \text{ Adc}, I_B = 1.0 \text{ Adc}$	$V_{CE(sat)}$			0.6 2.5	Vdc
Base-Emitter Saturation Voltage $I_C = 5.0 \text{ Adc}, I_B = 0.5 \text{ Adc}$ $I_C = 10 \text{ Adc}, I_B = 1.0 \text{ Adc}$	$V_{BE(sat)}$			1.5 25	Vdc

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Magnitude of Common Emitter Small-Signal Short-Circuit Forward Current Transfer Ratio $I_C = 0.2 \text{ Adc}, V_{CE} = 10 \text{ Vdc}, f = 10 \text{ MHz}$	$ h_{fe} $		1.5	7.5	
Forward Current Transfer Ratio $I_C = 50 \text{ mA}, V_{CE} = 5.0 \text{ Vdc}, f = 1.0 \text{ kHz}$	h_{fe}	2N4150, 2N4150S	40	160	
		2N5237, 2N5237S	40	160	
		2N5238, 2N5238S	40	250	
Output Capacitance $V_{CB} = 10 \text{ Vdc}, I_E = 0, 100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$	C_{obo}			350	pF

SWITCHING CHARACTERISTICS

Delay Time	$V_{CC} = 20 \text{ Vdc}, V_{BB} = 5.0 \text{ Vdc}, I_C = 5.0 \text{ Adc}, I_{B1} = 0.5 \text{ Adc}$	t_d		50	μs
Rise Time		t_r		500	μs
Storage Time	$V_{CC} = 20 \text{ Vdc}, V_{BB} = 5.0 \text{ Vdc}, I_C = 5.0 \text{ Adc}, I_{B1} = -I_{B2} = 0.5 \text{ Adc}$	t_s		1.5	μs
Fall Time		t_f		500	μs

SAFE OPERATING AREA

DC Tests					
$T_C = +25^\circ\text{C}, 1 \text{ Cycle}, t = 1.0 \text{ s}$					
Test 1					
$V_{CE} = 40 \text{ Vdc}, I_C = 0.22 \text{ Adc}$					
Test 2					
$V_{CE} = 70 \text{ Vdc}, I_C = 90 \text{ mA}$					
Test 3					
$V_{CE} = 120 \text{ Vdc}, I_C = 15 \text{ mA}$		2N5237, 2N5237S			
$V_{CE} = 170 \text{ Vdc}, I_C = 3.5 \text{ mA}$		2N5238, 2N5238S			

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300 μs , Duty Cycle \leq 2.0%.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331